

功率模块命名规则

G L 200 HF 60 T2 E

G = IGBT 模块
M = MOSFET 模块
R = 整流器模块

芯片特点

K=标准IGBT, 有短路保护能力
F=快速IGBT, 有短路保护能力
L=低损耗IGBT
U= 超快型IGBT
T=沟槽型IGBT, 低损耗
W=沟槽型IGBT, 快速
N=平面型MOSFET
M=沟槽型MOSFET
D=二极管
E=快恢复外延二极管
R=晶闸管
S=肖特基二极管

额定电流 (2到4位数字)

如 200=200 A, 50=50 A

电路结构

SG= 一单元
CU= 斩波 (二极管在高压侧)
CL= 斩波 (二极管在低压侧)
HF= 半桥
HB= 半桥 + 制动
HT= 三单元
HH= H桥
FF= 三相全桥
FB= 三相全桥 + 制动
PI = 二极管整流桥 + 制动 + 全桥
IP= 驱动 + 保护 + 全桥

测试等级

E= 通过电性能测试
H= 通过重要可靠性测试
S= 通过全面可靠性测试

封装类型

T1=94mmx34mm, 铜底板
T2=106mmx62mm, 铜底板
T3=140mmx130mm, 铜底板
T4=190mmx140mm, 铜底板
T5=107mmx45mm, 铜底板
T6=122mmx62mm, 铜底板
T7=150mmx62mm, 铜底板
T8=162mmx150mm, 铜底板
T9= 94mmx34mm, 无底板
A1=67mmx40mm, 无底板
A2=115mmx47mm, 混合底板
A3=140mmx130mm, 碳化硅铝复合底板
A4=190mmx140mm, 碳化硅铝复合底板

额定电压/10

如 60=600 V, 120=1200 V